

210半片0BB

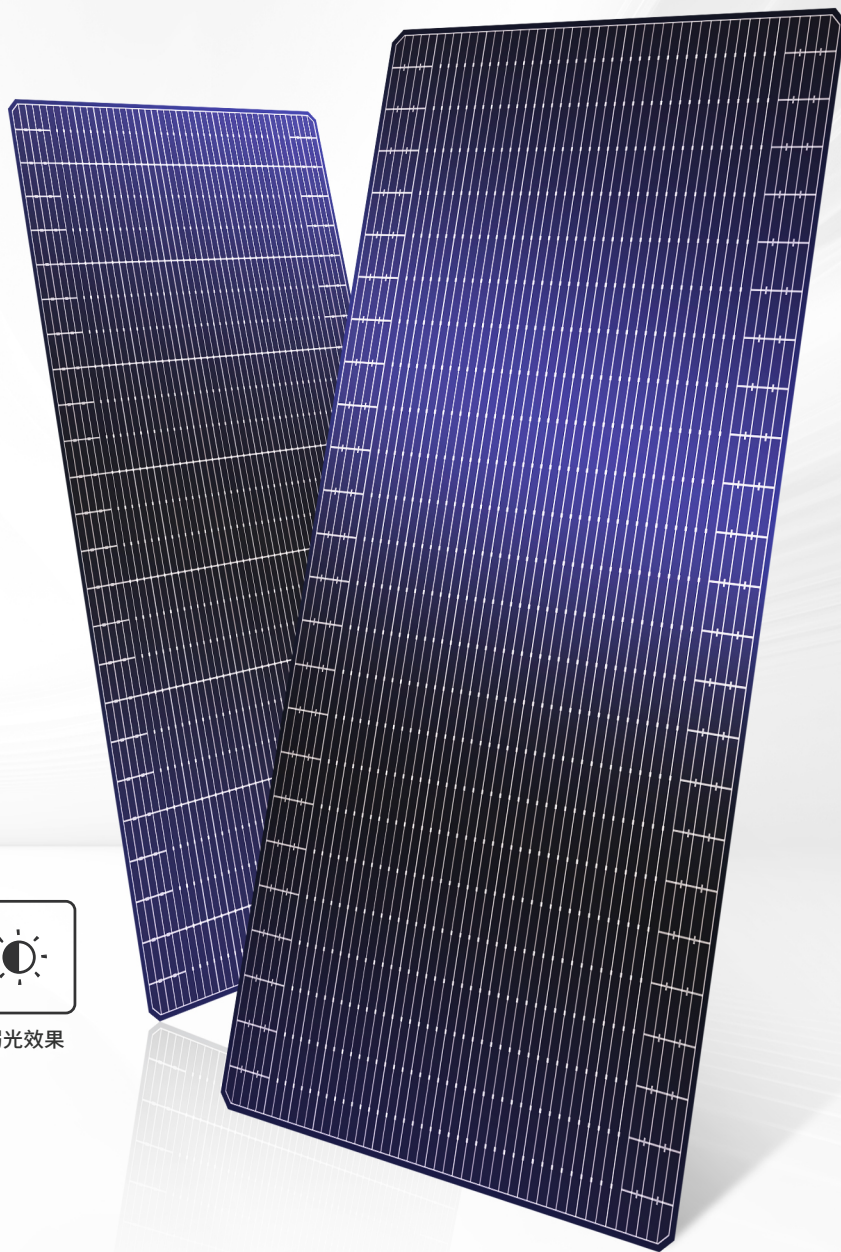
双面微晶高效异质结电池

N型单晶硅



效率高达

25.4%



无主栅
技术



高达95%
的双面率



薄片化



抗PID
保证



温度
系数低



N型电池
无LID



弱光效果

产品特征

尺 寸	210mm*105mm±0.25mm
基体材料	N 型单晶硅
硅片厚度	110um±20um
正 面(-)	54 根副栅线(银/银铜), 蓝色透明导电膜(TCO)
背 面(+)	118 根副栅线(银/银铜), 蓝色透明导电膜(TCO)
焊接拉力	≥1.2N

*该技术规格书最终解释权归珠海鸿钧所有

*规格书中的参数如有变更, 恕不另行通知

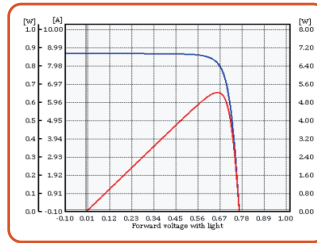


低辐照度下电性能参数

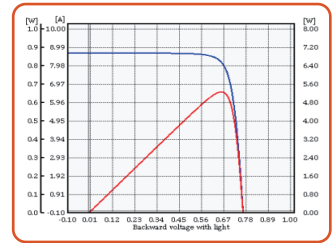
辐照度(W/m ²)	Voc	Isc
1000	1	1
900	0.99	0.9
800	0.99	0.8
600	0.98	0.6
400	0.96	0.4

*以 1000W/m² 测试的 Voc(Isc) 为标准, 测试 Voc(Isc) 随光强下降的幅度。

正面IV曲线



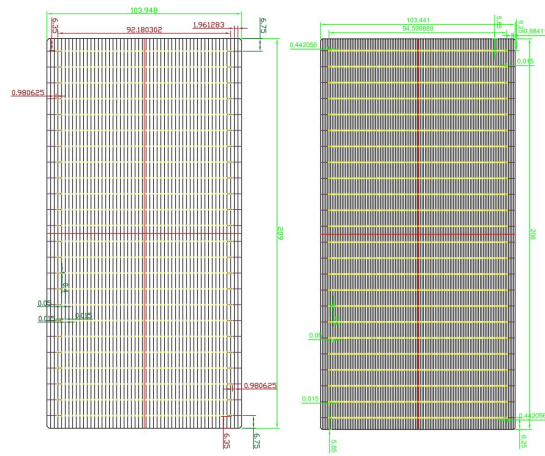
背面IV曲线



温度系数

Voc (%/K)	-0.27
Isc (%/K)	0.055
PMAX (%/K)	-0.26

装配图纸 (mm)

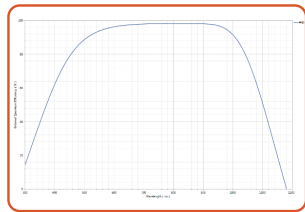


包装要求

每批次产品厂家应附产品检验报告详单;

产品包装需印有产品型号、生产日期等信息。

正面光谱响应(外量子效率)



储存要求

干燥、室温、通风阴凉处, 符合包装及储存条件下储存;

产品避免阳光直射、曝晒, 远离热源、火源;

储存期限根据产品标示的生产日期和有效期而定。

正面电性能参数

效率代码	效率(%)	最大输出功率 Pmp(W)	最大功率点电压 Vmp (V)	最大功率点电流 Imp(A)	开路电压 Voc(V)	短路电流 Isc(A)	填充因子 FF(%)
HJ-210-254	25.40%	5.6036	0.6808	8.2306	0.7513	8.5874	86.85
HJ-210-253	25.30%	5.5827	0.6793	8.2185	0.7508	8.5841	86.62
HJ-210-252	25.20%	5.5626	0.6775	8.2101	0.7505	8.5799	86.39
HJ-210-251	25.10%	5.5426	0.6756	8.2040	0.7497	8.5826	86.14
HJ-210-250	25.00%	5.5211	0.6736	8.1966	0.7487	8.5805	85.94
HJ-210-249	24.90%	5.5004	0.6719	8.1869	0.7483	8.5748	85.72
HJ-210-248	24.80%	5.4791	0.6701	8.1763	0.7480	8.5674	85.50
HJ-210-247	24.70%	5.4575	0.6682	8.1677	0.7474	8.5618	85.29
HJ-210-246	24.60%	5.4363	0.6662	8.1610	0.7464	8.5612	85.07
HJ-210-245	24.50%	5.4140	0.6640	8.1545	0.7461	8.5628	84.75
HJ-210-244	24.40%	5.3920	0.6659	8.0979	0.7489	8.5261	84.45
HJ-210-243	24.30%	5.3689	0.6612	8.1206	0.7456	8.5539	84.19
HJ-210-242	24.20%	5.3471	0.6609	8.0913	0.7464	8.5497	83.80
HJ-210-241	24.10%	5.3275	0.6605	8.0673	0.7478	8.5658	83.18
HJ-210-240	24.00%	5.3075	0.6601	8.0405	0.7476	8.5528	83.00
HJ-210-235	23.50%	5.2468	0.6516	8.0539	0.7467	8.5877	81.82

*标准测试条件: 1000W/m², AM1.5, 25°C

*以上技术参数受限于技术变更及测试, 鸿钧新能源有限公司保留最终解释权。

